## 量子化学Ⅱ 期末試験

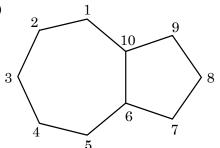
注意)記述式問題の記述量は「解答欄の枠に入る程度」とする。たくさん書きたい人は小さな文字で書けばよいです。解答欄の枠外に書いた内容は無効です。解答用紙は未記であっても、必ず2枚とも、2枚をホッチキスで留めて、提出すること。解答に於いて、講義中に(講義資料で)使った記号は説明無しに使ってよい。下書き用紙は用意しないので、問題・解答用紙の裏を使いなさい。

#### **設問 1** 以下の問いに答えよ。

- (1)PPP 法を特徴付ける最も重要な近似の(i)名称と、(ii)内容を説明せよ。但し、「分子軌道近似」、「LCAO 近似」、「 $\pi$ 電子近似」は除け(これらを書いたら減点対象とする)。
- (2)PPP 法では2電子原子積分(rr|rr)を、イオン化ポテンシャル $I_p$ と電子親和力 $E_a$ を使った式 $(rr|rr) = I_p E_a$ で計算する。この式の導出過程を簡潔に示せ。図や式を使ってよい。尚、(rr|rr) は講義中に定義した。
- (3)最低次 $(c^{-2})$ の3つの相対論補正項の各々について(a)(b)を述べよ。順序不同。
  - (a) 原子単位系で書いた式、及び、その呼称
  - (b) 補正の内容(役割・効果などについて)
- (4)以下に示す(a)(b)について両者の違いを簡潔に述べよ。個々の説明は不要である。
  - (a) 古典的 DFT と Kohn-Sham DFT
  - (b) 波動関数理論(WFT)と古典的な密度汎関数理論(DFT)

# 設問2

ヒュッケル法でアズレンの $\pi$ 分子軌道の計算を実行し、 軌道エネルギーの $\beta$ の係数x、分子軌道係数 $c_{sk}$ 、 $\pi$ 電子 密度 $n_s$ を表に示した。原子軌道の番号は右図に示す。



分子軌道番号 k		1	2	3	4	5	$n_s$
<b>βの係数</b> x <sub>k</sub>		2.3103	1.6516	1.3557	0.8870	0.4773	
	1	0.2886	-0.1909	-0.4841	-0.2186	0.1601	0.855
原	2	0.1998	-0.4333	-0.3571	0.1598	0.3355	0.986
子	3	-0.1730	-0.5247	0.0000	0.3603	0.0000	0.870
軌	4	0.1998	-0.4333	0.3571	0.1598	-0.3355	0.986
道	5	0.2886	-0.1909	0.4841	-0.2186	-0.1601	0.855
Ø	6	0.4670	0.1180	0.2992	-0.3536	0.2591	1.027
番	7	0.3233	0.2678	0.2207	0.2585	0.5429	1.173
号	8	0.2799	0.3243	0.0000	0.5829	0.0000	1.047
S	9	0.3233	0.2678	-0.2207	0.2585	-0.5429	1.173
	10	0.4670	0.1180	-0.2992	-0.3536	-0.2591	1.027

分子軌道は各原子の分子面外の 2p 軌道 χ<sub>s</sub> の線形結合で表現し、

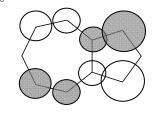
$$\phi_k = c_{1k} \chi_1 + c_{2k} \chi_2 + c_{3k} \chi_3 + \dots + c_{10k} \chi_{10} = \sum_{s=1}^{10} c_{sk} \chi_s$$

表中の電子密度 $n_s$ と「 $\beta$ の係数x」の定義は次式の通りである。

$$n_s = 2\sum_{k=1}^{5} c_{sk}^2$$
,  $\varepsilon_k = \alpha + x_k \beta$ 

この分子のヒュッケル計算の結果について以下の問いに答えよ。

- (1) 縦軸を軌道エネルギーとして、いつものような電子の 占有図を、なるだけ正確に描け。
- (2)共鳴エネルギーを「数値 $\times \beta$ 」で記せ。
- (3)右図の分子軌道はエネルギーの低い順に数えて何番目であるかを答えよ。



- (4)右上図の分子軌道の全ての節(node)を図中に記入せよ。節は**濃く太線**で示せ。
- (5)アズレンの 5 員環と 7 員環を比較して、π電子密度はどちらに偏っているか。前項の表から数値的根拠を算出して、それに基づいて理由を説明せよ。
- (6)ヒュッケル近似を使い(i)(ii)に答えよ。(i)次式のAを $c_s$ で示せ。(ii)前項の表の数値を使って、Aの値を計算せよ。

$$A = \int \phi_1 \, \phi_3 dv$$

### 設問3

水素分子の $\sigma$ 軌道 $\phi_1$ と $\sigma$ \*軌道 $\phi_2$ のみを考慮した2電子励起C I 法について検討する。分子軌道は規格化されており、Hartree-Fock 方程式を満たす。電子配置 $\Phi_K$ の番号は以下のように定義する。

エネルギー演算子 $\hat{H}$ をとして、CI 波動関数 $\Phi_{CI}$ と CI エネルギー $E_{CI}$ は次式となる。但し、波動関数とエネルギー演算子は実数であることを仮定している。

$$\Phi_{\text{CI}} = d_0 \Phi_0 + d_1 \Phi_1, \qquad E_{\text{CI}} = \frac{\int \Phi_{\text{CI}} \hat{H} \Phi_{\text{CI}} dv}{\int \Phi_{\text{CI}} \Phi_{\text{CI}} dv}$$

CI 方程式の記述に必要な積分は次式の通りである。

$$\int \Phi_K \hat{H} \Phi_L dv = H_{KL} \qquad (K, L = 0, 1)$$

エネルギー最小の $E_{cr}$ は次式となる。

$$E_{CI} = \frac{H_{00} + H_{11} - \sqrt{(H_{11} + H_{00})^2 - 4(H_{00}H_{11} - H_{01}^2)}}{2} \tag{*}$$

以下の問いに答えよ。

- $(1)d_K$ と $E_{CI}$ を決める CI 方程式を、 $d_K$ と $E_{CI}$ と $H_{KL}$ を使って書け。但し、K,L=0,1。
- (2)設問中の(★)式を導け。
- (3)|x| $\ll$ 1のとき $\sqrt{1+x}\approx1+x/2$ を使って、 $E_{\rm CI}$ の近似式を作り、電子相関エネルギーとなる部分を枠で囲め。但し、次式を仮定する。

$$\frac{H_{01}^2}{(H_{11} - H_{00})^2} << 1$$

 $(4)H_{01}$ を $h_1$ と $h_2$ と(ij|kl)のみを含む式で示せ。但し、

$$h_k = \int \phi_k(\mathbf{r}) \hat{h}(\mathbf{r}) \phi_k(\mathbf{r}) d\mathbf{r} , \qquad (i \ j \mid k \ l) = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \int \int \phi_i(\mathbf{r}_1) \phi_k(\mathbf{r}_2) \frac{1}{\left|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2\right|} \phi_j(\mathbf{r}_1) \phi_l(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2$$

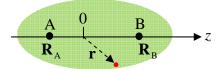
である。 $\hat{H}$ は次式とする。

$$\hat{H} = \hat{h}(\mathbf{r}_1) + \hat{h}(\mathbf{r}_2) + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}$$

(5)電子相関を考慮した方法で計算すると、化学結合距離は、Hartree-Fock 法で計算した結合エネルギーよりも長くなることが多い。この理由を述べよ。

### 設問 4

分子軸を Z 方向に置いた 1 電子系の直線 2 原子分子A - B を考える。



電子の位置座標を $\mathbf{r}$ 、原子A、Bの原子核の座標 $\mathbf{R}_{A}=(0,0,z_{A})$ 、 $\mathbf{R}_{B}=(0,0,z_{B})$ とする。分子のエネルギーEを $\mathbf{R}_{A}$ で微分すると、原子核Aに働く力 $\mathbf{f}_{A}=(0,0,f_{ZA})$ を得る。つまり、 $\mathbf{f}_{A}=-\frac{\partial E}{\partial \mathbf{R}_{A}}$ である。この式の $z_{A}$ 成分だけをとりだして書くと  $f_{ZA}=-\frac{\partial E}{\partial z_{A}}$ となる。

安定構造でない分子の場合、 $\mathbf{f}_{\mathbf{A}}$ は分子構造が安定な構造へ変化する力を与えている。  $\psi(\mathbf{r})$  を電子の波動関数、 $\mathbf{Z}_{\mathbf{A}}$  を $\mathbf{A}$  の原子番号とし、原子核を電子密度分布  $\rho(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r})^* \psi(\mathbf{r})$  の中に浮かんでいるプラス電荷  $e\mathbf{Z}_{\mathbf{A}}$  だと考えると、電子分布からその原子核が受ける力  $\mathbf{f}'_{\mathbf{A}}$  は、

$$\mathbf{f'}_{A} = e^{2} Z_{A} \int \frac{\mathbf{r} - \mathbf{R}_{A}}{4\pi\varepsilon_{0} \left| \mathbf{r} - \mathbf{R}_{A} \right|^{3}} \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} - e^{2} Z_{A} Z_{B} \sum_{B \neq A} \frac{\mathbf{R}_{B} - \mathbf{R}_{A}}{4\pi\varepsilon_{0} \left| \mathbf{R}_{B} - \mathbf{R}_{A} \right|^{3}}$$

となる。上式右辺の第2項は他の原子核から原子核 A が受けるクーロン反発力である。 一方、1電子系分子A-Bにおける電子状態のシュレーディンガー方程式は次式である。

$$\hat{H}(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r})$$

$$\hat{H}(\mathbf{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{e^2 Z_A}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|} - \frac{e^2 Z_B}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{R}_B|} + \frac{e^2 Z_A Z_B}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{R}_B - \mathbf{R}_A|}$$

以下の問いに答えよ。

(1)以下の微分式を計算せよ。誤魔化さず1ステップごとの計算過程を書くこと。

$$\frac{d}{dz}\frac{1}{\sqrt{z^2+a^2}}$$
 (zと a は実数)

(2) He11mann-Feynman 定理が成立すれば、 $\mathbf{f}_{A} = \mathbf{f'}_{A}$ であることを示せ。He11mann-Feynman 定理を使った箇所を明記すること。